
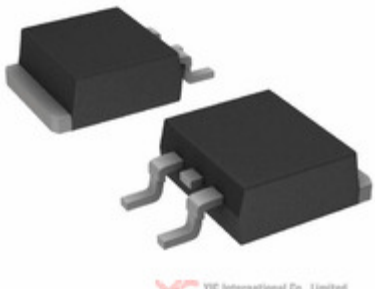
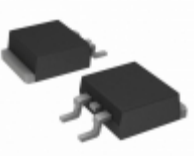
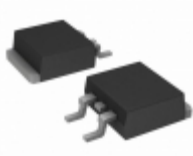


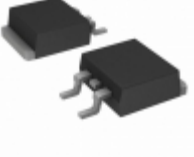



	<p>SIHB12N50E-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIHB12N50E-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-263</p> <p>Datenblätter:  SIHB12N50E-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 33 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHB12N50E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	33 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	114W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	886pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 10.5A (Tc) 114W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.5A (Tc)

SIHB12N50E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHB12N50E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHB12N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIHB12N50E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHB10N40D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 400V 10A DPAK</p>	 <p>SIHB12N50C-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 12A D2PAK</p>	 <p>SIHB12N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 12A TO263</p>	 <p>SIHB12N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 12A TO263</p>
 <p>SIHB12N50C-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 12A D2PAK</p>	 <p>SIHB12N50E VISHAY SIHB12N50E VISHAY</p>	 <p>SIHB12N50E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-263</p>	 <p>SIHB12N60E VISHAY SIHB12N60E VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHB12N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHB12N50E-GE3 Datenblatt	SIHB12N50E-GE3-Datenblätter	SIHB12N50E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIHB12N50E-GE3 Electronic	SIHB12N50E-GE3-Komponenten	SIHB12N50E-GE3-Verteiler	SIHB12N50E-GE3-Bild	SIHB12N50E-GE3
SIHB12N50E-GE3 Preis	SIHB12N50E-GE3 Hersteller	SIHB12N50E-GE3-Bild	SIHB12N50E-GE3 Aktie	SIHB12N50E-GE3-Teil
SIHB12N50E-GE3 Neu	SIHB12N50E-GE3 Original	SIHB12N50E-GE3 garantiert	SIHB12N50E-GE3 RFQ	SIHB12N50E-GE3 Inventar
				SIHB12N50E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited